

NPN Silicon Power Transistors

NPN Silicon Epitaxial Planar Transistors in SOT-9 (S0-55) metal case
For I.f. driver and output stages and high power switching

Type	Maximum Ratings			Characteristics at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$										
	V_{CB0} V	V_{CE0} V	V_{EB0} V	I_C A	P_{tot} W	T_i °C	$\theta_{case}^{\circ\text{C/W}}$	h_{21E}	h_{21E}	h_{21E}	$V_{CE\ sat}$ V	I_{CB0} μA	V_{CB0} V	f_T MHz
BD 106 A	36	36	5	2,5	11,5	175	< 13	50...150	—	> 35	< 1	< 0,5	32	100
BD 106 B	36	36	5	2,5	11,5	175	< 13	100...300	—	> 70	< 1	< 0,5	32	100
BD 107 A	64	64	5	2,5	11,5	175	< 13	50...150	—	(> 35)	< 1	< 0,5	60	100
BD 107 B	64	64	5	2,5	11,5	175	< 13	100...300	—	(> 70)	< 1	< 0,5	60	100
BDY 15 A	36	36	5	2,5	11,5	175	< 13	50...150	> 15	—	< 1	< 0,1	32	100
BDY 15 B	36	36	5	2,5	11,5	175	< 13	100...300	> 25	—	< 1	< 0,1	32	100
BDY 15 C	36	36	5	2,5	11,5	175	< 13	200...600	> 35	—	< 1	< 0,1	32	100
BDY 16 A	64	64	5	2,5	11,5	175	< 13	50...150	> 15	—	< 1	< 0,1	60	100
BDY 16 B	64	64	5	2,5	11,5	175	< 13	100...300	> 25	—	< 1	< 0,1	60	100

NPN Silicon H.F. Power Transistors

Data shown for types 3TE445—3TX603 are preliminary

Type	Maximum ratings				Characteristics @ $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$									
	case	V_{CB0} V	V_{CE0} V	V_{EB0} V	I_C A	P_{tot} W	G_{pe} dB	f MHz	P_o W	V_{CC} V	h_{21E}	V_{CE}/I_C V/A	f_T MHz	V_{CE}/I_C V/A
2 N 3375	TO-60 ³	65	40	4	1,5	11,6	> 4,8	400	3	28	5...50	5/0,25	> 400	28/0,125
2 N 3543	TO-3 ⁴	65	60	4	5	60	> 8	30	20	28	10...80	5/4,5	> 150	10/0,5
2 N 3553	TO-39 ²	65	40	4	1	7	> 10	175	2,5	28	10...100	5/0,25	> 400	28/0,125
2 N 3632	TO-60 ³	65	40	4	3	23	> 5,9	175	13,5	28	> 5	5/1	> 250	28/0,25
2 N 3733	TO-60 ³	65	40	4	3	23	> 4	400	10	28	> 5	5/1	> 250	28/0,25
2 N 3866	TO-39 ²	55	30	3,5	0,4	5	> 10	400	1	28	> 5	5/0,36	> 500	15/0,05
2 N 4012	TO-60 ³	65	40	4	1	11,6	tripler 0,3/1 GHz				> 10	5/1	> 400	28/0,125
2 N 4130	TO-3 ¹	80	80	4	10	120	> 8	70	50	28	> 10	5/10	> 125	10/2
2 N 4427	TO-39 ²	40	20	2	0,4	3,5	> 10	175	1	12	> 5	5/0,36	> 500	15/0,05
2 N 4440	TO-60 ³	65	40	4	1,5	11,6	> 4,7	400	5	28	> 3	5/1,35	> 400	28/0,125
2 N 5090	TO-60 ³	55	30	3,5	0,4	5	7,8	400	1,2	28	—	—	> 500	15/0,05
2 N 5214	Strip L.A	95	95	4	5	60	> 7	150	50	40	> 10	5/4,5	> 150	10/1
2 N 5215	TO-60 ³	70	70	4	1	23	> 5	200	10	28	10...80	5/1	> 400	10/0,5
2 N 5216	Strip L.B	80	80	4	1,5	25	> 4	400	15	40	> 10	5/1,5	> 350	10/0,5
2 N 5217	Strip L.B	80	80	4	0,5	7,5	> 7	400	4	40	> 10	5/0,5	> 350	10/0,2
2 N 5421	TO-39 ²	36	18	4	0,5	3	> 9	175	1	13,5	> 8	5/0,2	> 300	13,5/0,1
2 N 5422	TO-39 ²	36	18	4	1	5	> 8	175	2	13,5	> 8	5/1	> 300	13,5/0,2
2 N 5423	TO-60 ¹	36	18	4	2	12	> 6	175	5	13,5	> 15	5/2	> 300	13,5/0,3
2 N 5424	TO-60 ¹	36	18	4	4	20	> 5	175	13	13,5	> 15	5/4	> 250	13,5/0,4
3 TE 445	LIS ³	96	96	4	1,5	25	6,5	400	20	48	> 10	5/0,5	> 350	10/0,5
3 TE 467	LIS ³	60	28	4	—	15	4	400	2,5	12,5	30...120	5/0,5	> 900	12,5/0,22
3 TE 477	LIS ³	60	28	4	—	5	8	400	1	12,5	20...100	5/0,1	> 1100	12,5/0,07
3 TE 609	Strip A	80	60	4	8	60	8	150	50	28	10...75	5/1	> 250	10/1
3 TE 610	Strip A	80	80	4	8	85	7	150	100	40	10...75	5/1	> 250	10/1
3 TX 601	SOE.A	36	20	4	1	11,6	10	175	3	13,5	10...60	5/0,1	> 300	13,5/0,2
3 TX 602	SOE.A	36	20	4	4	20	7	175	13	13,5	20...100	5/0,2	> 250	13,5/0,4
3 TX 603	SOE.B	36	20	4	8	30	5	175	25	13,5	> 10	5/0,4	—	—

¹ Emitter connected to case

² For TO-39 dimensions see page 29

³ All leads isolated

⁴ Collector connected to case

Red = New Types